班过: 06011907 但名: 查里宁 学号 1120193146

- 13. ①因为有内电场作用, 且半导体材料 P和N各自只有一种多子易导电
 - ② 反向 电压图多大, 将 队结击率
 - ③温度升高、少子数量增多反向饱和电流增多进而正向特性左移、反向特性下移。 温度升高半导体也更易被击第

1-6. W 硅能压降为 0.7V.

]= 10-07 mA = 1.82 mA

(2) 1: Vn 3电性变磁, 1变太 Uo. 等效电阻变小, Uo.变小

9. 解考虑两管正、反向共回科情况正向电压均 0.7V, 则有 0.7Y 0.7: 1.4V 0.7+ 6= 1.7V 0.7+9= 9.7V 9+6=15V 四种状况 并, 考虑正反向, 亦有回接法并取取电压最小值, 放反有两种可能: 0.7V或 6 V.

|-10. (1) 设観 E 管正常 Us= 6V.

RL 10= 2 = 6 mA

RL: 1= U2-U2= >8 mA

Iz= I-20= 22 mA

对記 E 常, P= U1, Z= 3 mA > 22 mA

10<22 mB < 3 mB > 21 mB

(2) 同上沒有 20= 60 mA

- [2] 同上区月 2:63mA 2.-2<0. 假设错误。 起在管本证证工作 別有 い。 Rt Rt Rt V1 - 学 V x 3.3 V
- 13) RA开路 DJ 12- U1-U2=)8mA 10<28<学, 电路正常稳压